Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0100U000114

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-03-2000

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 2100 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442346674, 380442262347, 380442396594, 380442343243

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380445254020

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження фізичних механізмів нерівноважних процесів на поверхні напівпровідників та в напівпровідникових шаруватих структурах, розробка нових нанотехнологій і приладів на їх основі

Назва роботи англійською:

Investigation of the physical mechanisms of non-equilibrium processes on the surfaces of semiconductors and in the semiconductor layered structures, development of the new nano-technologies and devices based on that

Мета роботи українською:

Вивчення особливостей електричних, оптичних та фізико-хімічних ефектів, що виникають в просторово-обмежених (в тому числі квантово-розмірних) поліфазних мікро- та наноелектронних структурах. Проведення комплексних досліджень впливу поверхні на фізичні та фізико-хімічні процеси, що протікають в низькорозмірних напівпровідникових структурах.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Розробка фізичних моделей та технологій керування стимульованими процесами прискореного формування алмазоподібних плівок з високою емісійною ефективністю, фотоелектричного та фотохімічного перетворення, планарного та об'ємного гетерування в напівпровідниках. Оптимізація технологій створення сонячних елементів, радіаційних датчиків, газочутливих сенсорів, елементів лазерних та ін. пристроїв, в тому числі наноелектронних елементів.

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Литовченко В.Г.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження стимульованого йонно-променевого синтезу, розробка технологій виготовлення нового типу адсорбо-сенсорів та квантових структур. Дослідження процесів гетерування, структурної перебудови, поверхневої адсорбції. Комп'ютерне моделювання досліджуваних процесів

Початок етапу: 01.2000

Закінчення етапу: 12.2000

Вид звітного документа: Без звіту

Номер етапу: 2

Назва етапу: Дослідження просторового розподілу комплексу параметрів мікроелектронних структур після активних впливів. Отримання впорядкованих молекулярних шарів на напівпровідниках. Дослідження нелінійних ефектів.

Початок етапу: 01.2001

Закінчення етапу: 12.2001

Вид звітного документа: Без звіту

Номер етапу: 3

Назва етапу: Дослідження характеристик фаз, синтезованих молекулярно-променевою епітаксією та йонно-пучковими методами. Розробка сенсорів та фотоперетворювачів на основі поліфазних структур та молекулярних упорядкованих шарів. Дослідження аморфних і пористих кремнійових плівок, стимульованої електронної емісії в шаруватих структурах, розробка фізико-хімічних принципів оптимізації низькотемпературних мікроелектронних технологій. Виготовлення сенсорів і пристроїв відображення інформації на основі наноелектронних структур. Розробка напівпровідникових дозиметрів.

Початок етапу: 01.2002

Закінчення етапу: 12.2002

Вид звітного документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 621.315.55/.58:538.945, 621.315.592:383

Коди тематичних рубрик: 45.09.33

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Свєчников С.В.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.